

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертационной работе Ткаченко Романа Андреевича на тему «Импульсные газоразрядные индукционные лазеры на переходах молекулярного азота и нейтральных атомов неона и ксенона», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.6 – оптика

№		
1	Фамилия Имя Отчество	Бохан Петр Артемович
2	Ученая степень, шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация	Доктор физико-математических наук, 01.04.05 – Оптика
3	Ученое звание	нет
4	Академическое звание	нет
Место основной работы:		
5	Полное название организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
6	Ведомственная принадлежность	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
7	Тип организации	Научно-исследовательский институт
8	Занимаемая должность, подразделение	Главный научный сотрудник, лаборатория мощных газовых лазеров
9	Почтовый индекс, адрес	630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 13
10	Телефон	+7 (383) 333-10-91
11	Адрес электронной почты	bokhan@isp.nsc.ru

1. Lavrukhin M.A., Bokhan P.A., Gugin P.P., Zakrevsky Dm.E. 100-kHz RM calcium ion NIR laser. *Optics and Laser Technology*, V.170, 110174 (2024), doi.org/10.1016/j.optlastec.2023.110174
2. Bokhan P.A., Gugin P.P., Lavrukhin M.A., Glubokov N., Zakrevsky D.E. Nanosecond pulse breakdown in noble gases. *Physics of Plasmas*, V.30, 043504 (2023), doi:10.1063/5.0138062
3. Bokhan P.A., Gugin P.P., Lavrukhin M.A., Zakrevsky D.E., Schweigert I.V. Pulse-periodic gas discharge in atmospheric pressure helium with nanosecond excitation fronts, *Physics of Plasmas*, V.30, 103506 (2023), doi:10.1063/5.0164607
4. Лаврухин М.А., Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Д.Э. Лазер с высокой частотой следования на самоограниченных переходах иона кальция, *Письма в ЖТФ*, Т.49, В.19, 19 (2023), doi:10.21883/PJTF.2023.19.56267.19654
5. Бохан П.А., Журавлёв К.С., Закревский Д.Э., Малин Т.В., Фатеев Н.В. Механизмы оптического усиления в сильнолегированных $Al_xGa_{1-x}N:Si$ структурах ($x=0.56-1$). *Физика и техника полупроводников*, Т.57, 731 (2023), doi:10.61011/FTP.2023.09.56987.5627

